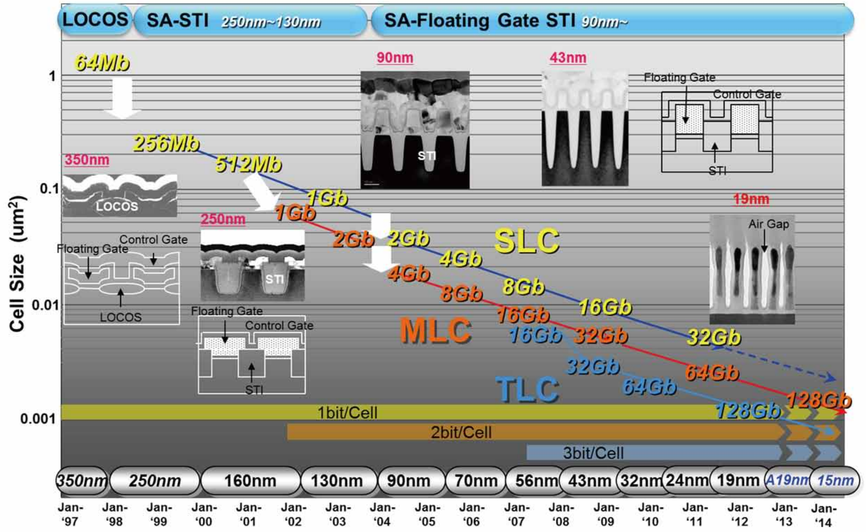
TOSHIBA
Leading Innovation

东芝非易失性存储器进程图

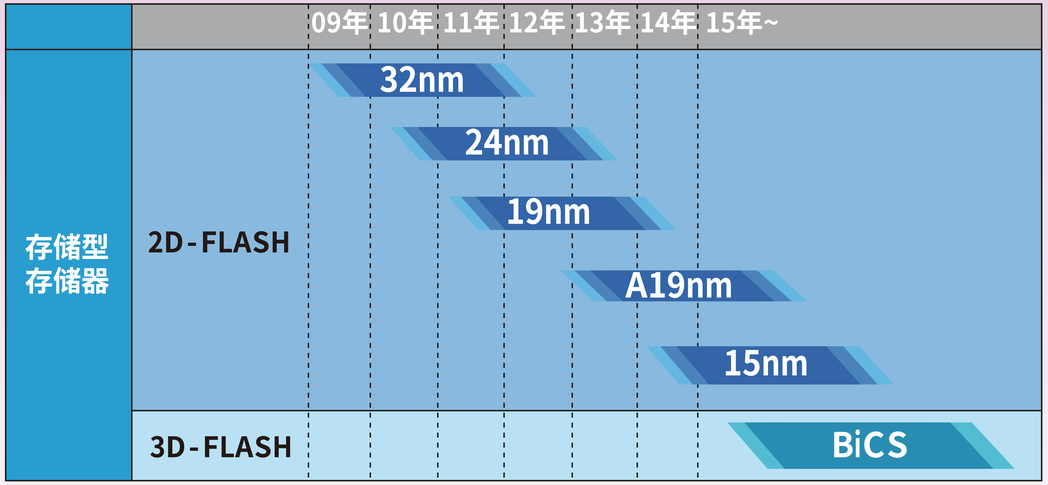
通过先进的工艺制程，多值化单元（MLC）以及贴装技术，东芝致力于开发更大容量和更高性能的存储器产品。同时东芝也 将继续致力于存储器技术的的不断创新。

NAND闪存技术进程图

浮动栅（FG）型NAND进程图



继续开发基于浮动栅（FG）结构的先进制程工艺技术。以实现大容量存储器的芯片尺寸的不断减小。通过3D结构的存储单元（BiCS），进一步加速芯片的大容量化。

下一代存储系统进程图

2014年东芝开始量产世界上第一款15nm制程NAND闪存